Hochwärmeleitfähige Siliciumnitrid-Keramik für die Leistungselektronik

Dr. Eveline Zschippang, M.Sc. Lea Schmidtner, Dr. Mathias Herrmann

Siliciumnitrid (Si₂N₄)-Werkstoffe zeichnen sich durch exzellente mechanische und tribologische Eigenschaften selbst bei hohen Temperaturen aus. Darüber hinaus kann durch Anpassung der Zusammensetzung und Mikrostruktur die Wärmeleitfähigkeit von Si₃N₄ auf bis 100 W/(m·K) eingestellt werden. Diese Kombination aus hoher Festigkeit und guter Wärmeleitfähigkeit ist unikal und führt zu einer sehr hohen Thermozyklenbeständigkeit und Lebensdauer von Si₃N₄-basierten Substraten. Diese Eigenschaften verbunden mit dem hohen elektrischen Widerstand und der Spannungsfestigkeit des Werkstoffs nutzt das Fraunhofer IKTS im BMWK-Projekt CuSiN (FKZ: 3ETE025) für die Entwicklung aktiv-gelöteter Kupfer-Siliciumnitrid-Verbunde (active metal brazed-Substrate, AMB) für den Einsatz als zuverlässige Schaltungsträger in der Leistungselektronik.

Im Rahmen einer Werkstoffanpassung im Labormaßstab wurden der Einfluss von Art und Menge der oxidischen Additive sowie der Si₃N₄-Pulverqualitäten untersucht. Aus kostengünstigen Si₃N₄-Pulvern mit niedrigem Sauerstoffgehalt und verringerten Aluminiumverunreinigungen konnten Werkstoffe mit Wärmeleitfähigkeiten von > 90 W/(m·K) realisiert werden. Die im Labormaßstab entwickelte Granulatzusammensetzung wurde in den kleintechnischen Maßstab (10 kg Skalierung) überführt. Aus den gut-pressfähigen Granulaten wurden über uniaxiales oder kaltisostatisches Pressen Blöcke mit den Abmessungen 320 x 230 x 45 mm bzw. 265 x 195 x 60 mm hergestellt. Beim Sintern großer Blöcke müssen Temperaturgradienten beim Aufheizen und Abkühlen berücksichtigt werden. Mittels Modellierung konnten kritische Spannungen während des Sinterprozesses abgeschätzt und die Sinterpraxis optimiert werden. Aus den gesinterten Blöcken stellte das Fraunhofer CSP in Halle

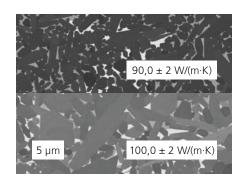
über Vieldrahtsägen 7,5 x 5,5 Zoll-Substrate her. Die erzielten Substrate mit niedriger Rauheit und hoher Ebenheit bedürfen keiner mechanischen Nachbearbeitung der Substratoberfläche für die nachfolgende Metallisierung. Zudem ist die Substratdicke von beispielsweise 320 μ m bis zu 100–150 μ m zielgenau einstellbar.

Neben der entwickelten AMB-Technologie qualifizierte das Forschungsteam auch Methoden für die Charakterisierung der Substrate hinsichtlich der Gefüge, der thermischen, mechanischen, elektrischen und dielektrischen Eigenschaften (Steinborn et al., S. 62 und Gnauck et al. S. 59).

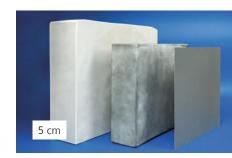
Durch weitere Optimierung des Werkstoffs und des Sinterregimes sind Wärmeleitfähigkeiten > 100 W/(m·K) realisierbar.

Leistungs- und Kooperationsangebot

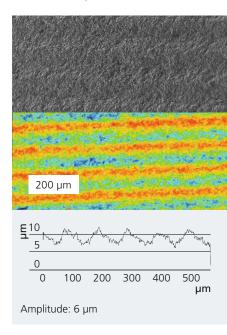
- Entwicklung von Nitridwerkstoffen mit applikationsoptimierten Eigenschaften
- Charakterisierung von Substraten hinsichtlich mechanischer, thermischer und elektrischer Eigenschaften



Gefüge einer Si_3N_4 -Keramik vor (oben) und nach (unten) der Sinteroptimierung.



Grün- und Sinterkörper aus Si_3N_4 sowie daraus über Drahtsägen am Fraunhofer CSP hergestelltes Substrat mit einer Dicke von 320 μ m.



Laserscanning-Mikroskopund FESEM-Aufnahme der gesägten Si₃N₄-Oberfläche.